

利用課題名：多極子秩序を示すカゴ状希土類化合物の結晶場励起に関する研究

Crystalline field study in clathrate rare-earth compounds with multi-polar ordering

北澤 英明¹⁾ 寺田典樹¹⁾ 土屋佳則¹⁾ 河村幸彦¹⁾

Hideaki KITAZAWA Noriki TERADA Yoshinori TSUCHIYA Yukihiko KAWAMURA

吉川明子¹⁾ デニ アンドレアス¹⁾ 酒井 治¹⁾ 松田 雅昌²⁾

Akiko KIKKAWA Andreas DÖNNI Osamu SAKAI Masaaki MATSUDA

加倉井 和久²⁾ 根本 祐一³⁾ 後藤 輝孝³⁾

Kazuhisa KAKURAI Yuichi NEMOTO Terutaka GOTO

¹⁾物材機構 ²⁾原子力機構 ³⁾新潟大院自然

3軸分光器TAS2による中性子非弾性散乱実験により、カゴ状構造をもつ立方晶系 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}(\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x)_6$ の希土類サイトにおける結晶場励起スペクトルを測定した。8cサイトの結晶場準位には、置換効果の影響は少ないが、4cサイトの結晶場準位が、xの減少とともに局在から非局在に変化する様子が明瞭に観測された。

キーワード：カゴ状希土類化合物、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ 、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Ge}_6$ 、結晶場励起、中性子非弾性散乱

1. 目的

カゴ状構造をもつ立方晶系 $\text{R}_3\text{Pd}_{20}\text{X}_6$ (R = 希土類元素; X=Ge, Si) は、図1に示すように磁性を担う希土類イオンのサイトとして、2つの結晶学的に異なるサイト4a (fcc 副格子) と8c (単純立方格子) が存在する。前者がPdとX原子のカゴに、後者がPdのみからなるカゴに囲まれている。ごく最近、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ において、四極子秩序($T_Q = 0.52$ K)と反強磁性($T_N = 0.33$ K)が競合していることが明らかとなり、典型的な近藤効果と四極子秩序の競合する CeB_6 との対比と言う観点から、興味を持たれている¹⁾。また、 $\text{R}_3\text{Pd}_{20}\text{Ge}_6$ においても、最近、超音波実験において観測された弾性定数の異常分散や低温でのソフトニングが、カゴの中に閉じこめられた希土類イオンのラットリング運動やトンネリングに起因していると言う指摘がなされており、新しい物理現象として非常にホットな話題となっている²⁾。

これまでA. Donniらによって行われた $\text{R}_3\text{Pd}_{20}\text{X}_6$ の系統的な中性子粉末回折実験によって、R=Ce, Prを除く磁気構造のおおよその全体像が明らかになってきた³⁾。しかし、物理的に非常に興味深いR=Ce, Prにおける2つのサイトにおける結晶場基底状態が未解明のため、これらの低温における物理の理解が進んでいなかった。2007年度の施設共用時には、2つの結晶場サイトが分離できる可能性の高い $\text{R}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ (R=Ce, Pr)の結晶場準位スキームを3軸分光器TAS1、TAS2、LTASを用いた中性子非弾性散乱(INS)実験を行った。R=Ceに関しては、3.8meVにのみ結晶場励起に関係する非弾性ピークを観測した。 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Ge}_6$ では、8cサイトと4aサイトにおける結晶場励起がそれぞれ観測された⁴⁾事と比べると、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ の結果は対照的である。つまり、同じ結晶構造を有する

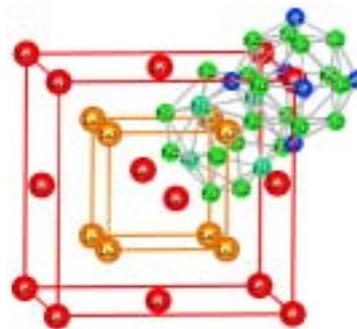


図1. $\text{R}_3\text{Pd}_{20}\text{X}_6$ の結晶構造。赤い球が4aサイト(fcc副格子)、オレンジ色の球が、8cサイト(単純立方格子)の希土類Rイオンを示す。

Ce₃Pd₂₀Si₆とCe₃Pd₂₀Ge₆では、低温での振る舞いが大きく異なっているばかりでなく、常磁性領域における結晶場スペクトルにおいても、大きな違いがあることを示唆している。そこで、Ce₃Pd₂₀Si₆の8cサイトはCe₃Pd₂₀Ge₆同様に局在性が強く（結晶場が観測されているので）が、4cサイトは近藤効果等の影響で非局在性がCe₃Pd₂₀Ge₆に比べて増加しているのではないかと仮説を立て、混晶系Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆のINS実験を系統的に行うことで、何かヒントが得られるのではないかと考えた。2008年度のTAS2を用いたマシンタイムでは、結晶場励起スペクトルが混晶系Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆濃度と併にどのように変化するかを調査した。

2. 方法

Ce₃Pd₂₀Si₆における観測されていないもう1つの励起を探索するために、3軸分光器TAS2を用いて混晶系Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆のINS実験を行った。Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆ (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1)の粉末試料(15-20 g)をクローズドサイクルのヘリウム冷凍機で最低到達温度の5Kに冷却した後、コンスタントQモード(Q = 1.3 Å⁻¹)で、E_A=13.7 meVに固定した状態で入射エネルギーを変化させて、-2.1 meVから12meVまでの励起エネルギーΔEを変えてINSスペクトルを測定した。さらに、磁気励起であることを確認するために、Q = 3.5 Å⁻¹で同様の測定を行った。

3. 研究成果

図2にCe₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆ (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1)の5KのコンスタントQモード(Q = 1.3 Å⁻¹)のINSスペクトルを示す。x=1では、4.0 meVに中心を持ち、半値幅0.8 meVのピークAの他に5.5 meVにピーク中心を持ち、半値幅1.1 meVの弱いサテライトBが存在することがわかる。一方、x=0.5では、サテライトピークBは露わに見えないが、ピークAが、高エネルギー側に裾を引いた非対称な形になり、かつ半値幅も広がっていることから、ピークAにピークB重なってしまっていると推察される。さらにx=0.3では、ピークA位置は、ΔEが最大となり、x<0.3では、xの減少と共にΔEは減少に転じている。ピークAの非対称度はx=0.1でも見えるが、x=0となるとピークAの半値幅が急に狭くなり、かつ対称に見える。

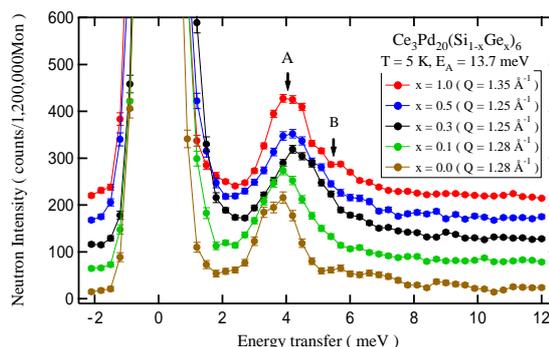


図2. Ce₃Pd₂₀(Si_{1-x}Ge_x)₆ (x = 0, 0.1, 0.3, 0.5, 1)の5Kにおける中性子非弾性散乱スペクトル。見やすいように縦軸を50カウントずつずらしている。

4. 結論・考察

L. Kellerらは、Ce₃Pd₂₀Ge₆のINS実験において、4 meVと5.4 meVを中心としたAおよびBのピークを観測し、強度比より、それぞれ8cサイト、4aサイトでのΓ₈ Γ₇の遷移と同定した⁴⁾。今回行われたCe₃Pd₂₀Ge₆のINS実験では、スペクトルの形に関しては、L. Kellerらの実験をほぼ再現した。従って、Ce₃Pd₂₀Ge₆でCeの2つのサイトで明瞭に結晶場が観測されたことから、Ce₃Pd₂₀Ge₆では、どちらのサイトも局在モデルを出発点として良いと言える。また、AとBのピーク強度比ばかりでなく、Siサイトに置換されGeは、選択的に4aサイトのCeの周りのカゴにのみ入っていくので、ピークAが元素置換に敏感でないことから、ピークAが8cサイト、ピークBが4aサイトと同定して良いであろう。注目すべきは、Geのサイトを等電子原子Siで置換していくと、8aサイトのCeの局在性は不変であるが、4aサイトのCeの局在性がだんだんと失われて行くことがはっきりとわかる。上述のスペクトル変化を眺める限りにおいては、

以前提案されていた 4a サイトの Ce の基底状態が、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Ge}_6$ と $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ で逆転しているというモデルは不自然であると考えた方が妥当であろう。一方、最近の後藤らによる $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ 単結晶を用いた超音波計測から求めた弾性定数の温度変化からは、8c サイトは Γ_8 基底状態、4a サイトは Γ_7 基底状態の可能性を指摘している⁵⁾。また、我々の NIMS ハイブリッド磁石を用いた $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ 単結晶の強磁場磁化測定の結果から、少なくとも片方の基底状態は Γ_8 でないと磁気異方性を説明するのは困難であるという結論を得ている。さらに $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Ge}_6$ 単結晶の強磁場磁化の異方性の振舞い⁶⁾も我々の $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}\text{Si}_6$ の結果と似通っている。これらを総合すると、 $\text{Ce}_3\text{Pd}_{20}(\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x)_6$ 混晶系における 8c サイトの Ce の 4f 電子の基底状態は Γ_8 で、4a サイトの Ce の 4f 電子の基底状態は Γ_7 であり、4a サイトは、Ge を Si に置換することで、局在性を失って、より遍歴的になっている、あるいは近藤温度が高くなっていくと推測される。このシナリオの妥当性をより堅固するために、今後低エネルギー励起実験を行い、近藤温度との相関を調べる事が重要と思われる。

5 . 引用(参照)文献等

- 1) S. Paschen, M. Muller, J. Custers, M. Kriegisch, A. Prokofiev, G. Hilscher, W. Steiner, A. Pikul, F. Steglich and A.M. Strydom, *J. Magn. Magn. Matt.* 316 (2007) 90.
- 2) T. Goto, Y. Nemoto, T. Yamaguchi, M. Akatsu, T. Yanagisawa, O. Suzuki and H. Kitazawa, *Phys. Rev. B* 70 (2004) 184126.
- 3) T. Herrmannsdörfer, A. Donni, P. Fischer, L. Keller, S. Janssen, A. Furrer, B. van den Brandt and H. Kitazawa, *Materials Science Forum* 443-444 (2004) 233.
- 4) L. Keller, A. Donni, M. Zolliker and T. Komatsubara, *Physica B* 259-261 (1999) 336.
- 5) T. Goto, T. Watanabe, S. Tsuduku, H. Kobayashi, Y. Nemoto, T. Yanagisawa, M. Akatsu, G. Ano, O. Suzuki, N. Takeda, A. Donni and H. Kitazawa, *J. Phys. Soc. Jpn.* 78 (2009) 024716.
- 6) N. Kimura, N. Tateiwa, M. Nakayama, H. Aoki, T. Komatsubara, T. Sakon, M. Motokawa, Y. Koike, N. Metoki, *Physica B* 259-261 (1999) 338.